

「マイクロナノスケールのトライボロジー」 正誤表

ページ	行	誤	正
22	本文上から 2 行目	下地層をもつため であること	下地層により軽減 できること
29	式(2.2)下へ 1 行目	$R_a$ と $R_q$ は大きさが 相似的である	$R_a$ と $R_q$ は大きさが 同程度である
49	式(3.11)下へ 1 行目	平均圧力 $p_o$	平均圧力 $p_m$
50	式(3.13)下へ 1 行目	接触面積 $a$	接触半径 $a$
58	式(3.32)下へ 2 行目	$\psi \leq 1$	$\psi \geq 1$
60	式(3.36)上へ 5 行目	$R = 100 \mu\text{m}$	$R = 200 \mu\text{m}$
62	簡条書き 3 の 3 行目	個体・個体接触	固体・固体接触
67	本文上から 10 行目	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$
74	4.2.3 節下へ 2 行目	脆性材料	延性材料
75	本文上から 2 行目	式(4.5)または(4.6)	式(4.5)または(4.11)
123	式(6.6)上へ 1 行目	$W = \gamma_{polystyrene}$	$W = 2 \gamma_{polystyrene}$
139	図 6.8 のキャプション, 上から 3 行目	Honoma	Homola
152	式(7.7)の分数式の分子の 文頭	$3kTa_1 a_2 \dots$	$3kTa_1^3 a_2^3 \dots$
169	7.3.6.1 節下へ 2 行目	図 6.9(a)	図 6.10(a)
179	図 7.13 のキャプション, 下から 3 行目	逆三面記号	逆三角記号
216	図 8.10(a)	Sl(100)	Si(100)
234	9.4 節下へ 10 行目	滑らない境界条件	スリップのない境 界条件
240	本文上から 10 行目	高分子の滑り	高分子のスリップ
288	式(10.12)の右辺第 2 項の 分子	$A_{\text{Si}} + A_{\text{SiOx}}$	$A_{\text{Si}} - A_{\text{SiOx}}$
327	式の番号	式(11.12)	式(11.22)